

Informacja o międzynarodowych konferencjach, seminariach, targach, wystawach – 1992 r. – cz. 2

(część 1 dot. lat 1991-1992 została opublikowana w numerze 1/91 "Materiałów Elektronicznych")

Dane dot. konferencji	Termin	Dane dot. organizatora	Uwagi
1	2	3	4
HYPER '92 Technologie des Hyper Frequences Microwave Technology Exhibition/Conference	01-21/23-1992 Paris, France	B.I.R.P. 25, Rue d'Astong 75008 Paris, France	program w DS-3
2nd World Congress on Implantology and Biomaterials	03-11/14-1992 Paris, France	CMIB 92, 57 Av. de Bretagne, 6100 Rouen, France	
International Zurich Seminar on Digital Communications "Intelligent Networks and their Applications"	03-16/19-1992 Zurich, Switzerland	Walter Schlegel Ascom Tech Ltd. Freiburgstrasse 370 CH-3018 Bern, Switzerland Tel.: (+41-31) 63 21 36, Fax: (+41-31) 55 52 11 E-mail: schlegel tech. ascom.ch	program w DS-3
PCIM '92 Power Electronics Drives and Motion International Conference and Exhibition	04-28/30-1992 Nürnberg	ZM Communications GmbH, Kleinreuther Weg 58 8500 Nürnberg 10 Germany, Tel. 09 11/36 70 59 Fax 09 11/36 45 22	program w DS-3
International Powder Metallurgy Conference	06-21/26-1992 San Francisco, USA	Metal Powder Industries Fed., C.J. Trombino, Dir. Mtgs and Admin., 105 College Rd East, Princeton, New Jersey 08540, USA	
Seventh World Conference on Titanium	06/28/07/02- -1992 San Diego, CA, USA	TMS Attn: Meetings Department 420 Commonwealth Drive Warrendale, PA 15086. Tel. (412) 776-9050, fax. (412) 776-3770	program w DS-3
International Metallographic Society 25 Annual Meeting	07-1992 Montreal, Canada	PO BOX 2489, Columbus OH 43216, USA	
European Crystallographic Committee 14th Meeting	08-1992 Enschede, Netherlands	BP 237, Le Bardo, 2000 Tunis, Tunisia	
International Confederation for Thermal Analysis 10th Triennial Congress	08-1992 Hatfield, UK	Prof. D.V. Nowell, Div. of Chemical Sciences, School of Natural Sciences, Hatfield Polytechnic, College Lane, Hatfield Herts AL 10 9AB, UK	
ISSCG-8	08-09/14-1992 Palm Spring, CA, USA	C.D. Brandle ICCG-10 Secretariat AT and Bell Laboratories, Room 7C-403 600 Mountain Avenue Murray Hill, NJ 07974-2070, USA	program w DS-3
ICCG-10	08-16/22-1992 San Francisco, CA, USA	C.D. Brandle ICCG-10 Secretariat AT a. T Bell Laboratories, Room 7C-403, 600 Mountain Avenue, Murray Hill, NJ 07974-2070, USA	program w DS-3

1	2	3	4
ISSSE 92 Deuxieme Symposium International sur les Signaux, les Systemes et l'Electronique	09-01/04-1992 Paris, France	Mme Yela STEVANOVIICH, ISSSE 92-B.P. 2, Uccle 3 B-1180 Bruxelles (Belgique) - Tel. ou Fax: 322 358 1966	program w DS-3
International Union of Crystallography 16. Triennal General Assembly and Congress	09-01/08-1992 Pekin	5 Abbey Square, Chester CH1 2HU, UK	
EMC '92 Eleventh International Wroclaw Symposium on Electromagnetic Compatibility	09-02/04-1992 Wroclaw, RP	EMC Symposium Box 2141, 51-645 Wroclaw 12, Poland	program w DS-3
IVC-12 International Union for Vacuum Science Technique and Applications-12th Triennal Congress	10-12/16-1992 Hague, Netherlands	Van Namen a. Westerlaken Congress Organization Services P.O.Box 1558 6501 BN Nijmegen The Netherlands Telephone: +31-80-234471 Telefax: +31-80-601159	program w DS-3
ICSS-8 Eight International Conference on Solid Surfaces	10-12/16-1992 Hague, Netherlands	Van Namen a. Westerlaken Congress Organization Services P.O.Box 1558 6501 BN Nijmegen The Netherlands Telephone: +31-80-234471 Telefax: +31-80-601159	program w DS-3

Wystąpienia pracowników ITME na konferencjach

Dni cyny w Polsce. Konferencja zorganizowana przez International Tin Research Institute (ITRI), Warszawa 21 ÷ 22.05, Kraków 23 ÷ 24.05.1991

Edmund TOMASIK

INSTYTUT TECHNOLOGII MATERIAŁÓW ELEKTRONICZNYCH

ul. Wólczyńska 133, 01-919 Warszawa

STOPY CYNY, ODPORNE NA UTLENIANIE

Podstawowymi spoiwami stosowanymi do lutowania w elektronice i elektrotechnice są spoiwa cynowo-ołowiowe. Ich własności fizykochemiczne i technologiczne zależą od zawartości pierwiastków będących dodatkami stopowymi lub zanieczyszczeniami.

Z cyny, ołowiu i fosforu czerwonego o czystości 99.999% wykonano 6 eutektycznych stopów SnPb o zawartości 7, 30, 70, 95, 140 i 320 ppm fosforu, które poddano badaniom. Wykonano badania termograwimetryczne utleniania w atmosferze powietrza, badania napięcia powierzchniowego metodą max. ciśnienia Ar w pęcherzyku gazowym oraz badania lutowalności metodą rozpliwności. Badania przeprowadzono w temperaturze 673 K.

Badano strukturę stopów metodami metalografii i mikroskopii elektronowej. Zbadano oporność właściwą stopów i wytrzymałość na ścinanie złączy lutowanych. Stwierdzono, że dodatek 0.01% wag. fosforu do eutektycznego stopu SnPb zmniejsza 15-krotnie utlenianie spoiwa, zmniejsza jego napięcie powierzchniowe o ok. 4%, nie pogarszając pozostałych badanych własności. Na tej podstawie opracowano spoiwo do lutowania elementów elektronicznych, które znalazło szerokie zastosowanie w przemyśle, przynosząc znaczne oszczędności cyny oraz poprawę jakości lutowania.

Pełny tekst wystąpienia opublikowany będzie w materiałach z ww. konferencji.

**RAMIS'91. Phase Transitions and Nonlinearity,
Poznań 8 + 11.04.1991**

Ryszard JABLONSKI

INSTITUTE OF ELECTRONICS MATERIALS TECHNOLOGY

133 Wólczyńska Str., 01-919 Warszawa

ESR MEASUREMENTS OF BiCaSrCuO SINGLE CRYSTAL

In this work we present ESR measurement magnetic penetration depth λ on adsorbed diphenyl picrylhydrazil (DPPH) at the surface of a single crystal high- T_c superconductor BiCaSrCuO. The temperature dependence of λ is found to follow the relationship [1] $\lambda = \lambda_0 [1 - (T/T_c)^4]^{-1/2}$ $\langle \Delta H^2 \rangle = 0.00371 \phi_0^2 / \lambda^4$.

REFERENCES

1. Brandt E.H.: Phys. Rev. B37, (4), 2349 (1988)

Pełny tekst wystąpienia opublikowany będzie w czasopiśmie Acta Physica Polonica.A.

Ryszard JABŁOŃSKI
INSTITUTE OF ELECTRONICS MATERIALS TECHNOLOGY
133 Wólczyńska Str., 01-919 Warszawa

A. MAZIEWSKI
INSTITUTE OF PHYSICS, WARSAW UNIVERSITY BRANCH BIAŁYSTOK
41 Lipowa Str., 15-424 Białystok

PECULIARITIES OF FMR TEMPERATURE DEPENDENCY IN $(YCa)_3(FeCoGe)_5O_{12}$ FILMS

Recently, epitaxial garnets films (grown on $\langle 100 \rangle$ plane of GGG substrate) doped by cobalt ions have been intensively investigated due to their interesting magnetic as magneto-optical properties. Some new phenomena (e.g. domain structure shape memory, self biasing effect in a homogenous magnet) have been observed [1].

To understand magnet properties it is very important to know its magnetic anisotropy. For this purpose investigations of FMR temperature dependency has been undertaken in the reported work.

The FMR measurements were carried out in dependence on temperature (between room and liquid temperatures) using X band ESR spectrometer. A maximum value of $H_{res}(T)$ for magnetic field applied along $\langle 100 \rangle$, $\langle 001 \rangle$, $\langle 110 \rangle$ axes was observed in the region 180-200 K.

Below 200 K $H_{res}(T)$ value decreased and near 125 K the signal of FMR was practically nonmeasurable. The observed line width $\Delta H_{pp} = 100$ mT was independent on temperature. The obtained results are probably connected with on existence of strongly anisotropic Co^{2+} ions occupied crystallographic octahedral position in crystallographic lattice.

REFERENCES

1. Maziewski A.: J. Mag. Mag. Mat. 88, 325, 1990

Pełny tekst wystąpienia opublikowany będzie w czasopiśmie Acta Physica Polonica.A.

Ryszard JABŁOŃSKI, Waldemar GIERSZ, Zygmunt ŁUCZYŃSKI
INSTITUTE OF ELECTRONICS MATERIALS TECHNOLOGY
133 Wólczyńska Str., 01-919 Warszawa

PHOTO-ESR STUDIES OF POINT DEFECTS INDUCED BY HEAT TREATMENTS IN LiNbO_3

A serie of undoped and doped LiNbO_3 single crystals have been subjected to heat treatments in a reducing atmosphere (in vacuum). That annealing creates a Nb^{4+} ESR spectrum. Optical illumination of samples with use of 50 W Hg arc lamp at 4 K leads to significant increase the obtained spectrum. On the otherhand, reoxidization of vacuum treated samples leads to decrease of Nb^{4+} ESR spectrum.

A new ESR spectrum was also observed in LiNbO_3 samples in which Ti was introduced by evaporating of Ti on the polished sample sufrage, heating at 800-1000°C and finally reoxidizing in an atmosphere of oxygen.

Pełny tekst wystąpienia opublikowany będzie w czasopiśmie Acta Physica Polonica.A